









	<h2>SI3458BDV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3458BDV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 4.1A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3458BDV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 21071 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3458BDV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 4.1A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21071 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 4.1A (Tc) 2W (Ta), 3.3W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.3W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3458BDV-T1-GE3-ND

SI3458BDV-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI3458BDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3458BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3458BDV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3457DV_NL Fairchild/ON Semiconductor SI3457DV_NL FAIRCHILD</p>	 <p>SI3458DV Vishay Precision Group SI3458DV VISHAY</p>	 <p>SI3458DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 3.2A 6-TSOP</p>	 <p>SI3458BDV VISHAY VISHAY SOT-163</p>
 <p>SI3458BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 4.1A 6-TSOP</p>	 <p>SI3458DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 3.2A 6-TSOP</p>	 <p>SI3458DV-T1-E3CT-ND Vishay Precision Group SI3458DV-T1-E3CT-ND VISHAY</p>	 <p>SI3458BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 4.1A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3456DDV-T1-GE3	 SI3456DV	 SI3456DV-NL	 SI3456DV-T1	 SI3456DV-T1-E3
 SI3456DV-T1-GE3	 SI3457-B02-IT	 SI3457BDV	 SI3457BDV-T1	 SI3457BDV-T1-E3
 SI3457BDV-T1-E3	 SI3457BDV-T1-GE3	 SI3457BDV-T1-GE3	 SI3457CDV-T1-E3	 SI3457CDV-T1-E3
 SI3457CDV-T1-GE3	 SI3457CDV-T1-GE3	 SI3457DV	 SI3457DV	 SI3457DV-T1
 SI3457DV-T1-E3	 SI3457DV-T1-GE3	 SI3457DV-T1-E3	 SI3458BDV-T1-E3	 SI3458BDV-T1-E3
 SI3458BDV-T1-GE3	 SI3458DV-T1-E3	 SI3458DV-T1-E3	 SI3458DV-T1-GE3	 SI3459BDV-T1-E
 SI3459BDV-T1-E3	 SI3459BDV-T1-E3	 SI3459BDV-T1-GE3	 SI3459BDV-T1-GE3	 SI3459DV-T1-E3
 SI3459DV-T1-E3	 SI3459DV-T1-GE3	 SI3460-E02-GMR	 SI3460-E03-GMR	 SI3460BDV-T1-E3
 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-GE3	 SI3460BDV-T1-GE3	 SI3460DDV	 SI3460DDV-T1-GE3
 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DV	 SI3460DV-T1	 SI3460DV-T1-E3	 SI3460DV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

